

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

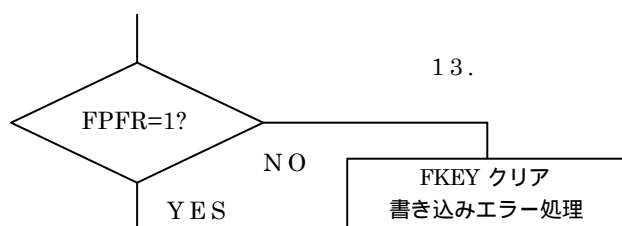
製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-H8*-A293A/J	Rev.	第 1 版
題名	フラッシュメモリ(0.18um F-ZTAT 版) 書き込み手順フローの誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	HD64F2378 HD64F2378R	対象ロット等 全ロット	関連資料	H8S/2378グループ、H8S/2378Rグループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0094-0400H Rev.4.00)	

H8S/2378 グループ、H8S/2378R グループ ハードウェアマニュアルにおきまして、フラッシュメモリ(0.18um F-ZTAT 版) 書き込み手順フローに関する誤記、及び追記がございますので、訂正のご連絡を致します。
詳細は、以下の参照をお願いいたします。

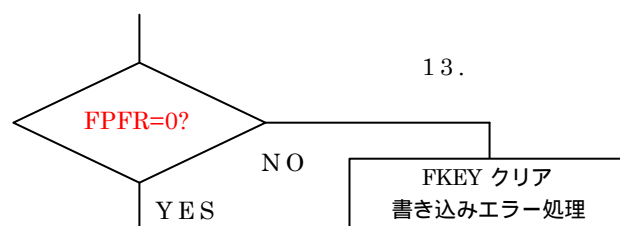
< 訂正内容 >

- 21-26 ページ「図 21.11 書き込み手順」のフローについて、FPFR の判定条件値の誤記を訂正します。

【変更前】

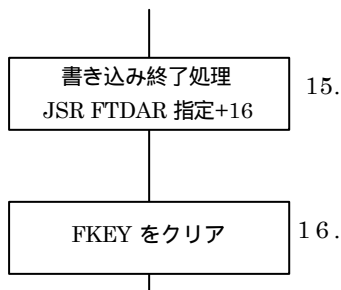


【変更後】

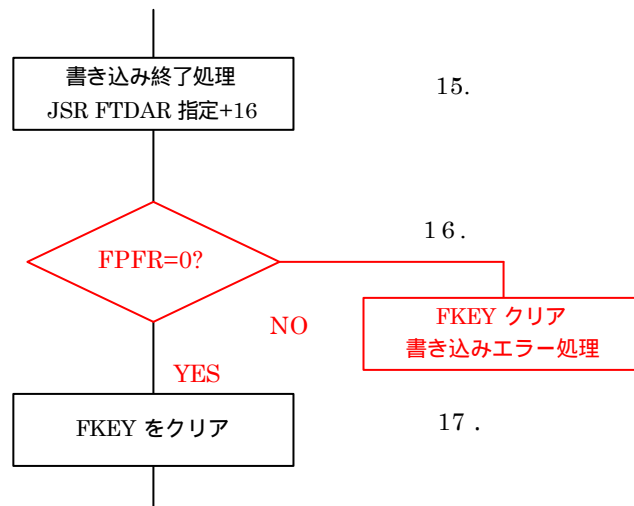


- 21-26 ページ「図 21.11 書き込み手順」のフローについて、FPFR の判定処理を追記します。

【変更前】



【変更後】



3. 21-30 ページ「15. 書き込み終了処理の実行」のサブルーチンコールプログラムの誤記を訂正します。

【変更前】

```
MOV.L #F0F0F0F0,ER0:
```

```
MOV.L #0F0F0F0F,ER1:
```

【変更後】

```
MOV.L #F0F0F0F0,ER0:
```

```
MOV.L #0F0F0F0F,ER1:
```

4. 21-31 ページ FPFR の判定処理の説明を追記します。

【変更前】

16.書き込みが終了したら FKEY をクリアして、ソフトウェアプロテクトを掛けてください。

ユーザマットへの書き込み完了直後、パワーオンリセットで再起動する場合は通常より長い 100 μs 以上のリ

【変更後】

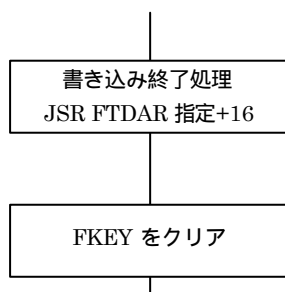
16.書き込みプログラムの戻り値 FPFR (汎用レジスタ R0L) を判定します。

17.書き込みが終了したら FKEY をクリアして、ソフトウェアプロテクトを掛けてください。

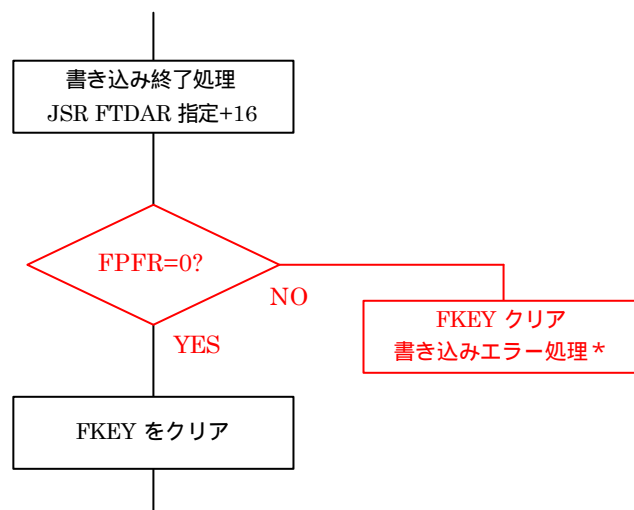
ユーザマットへの書き込み完了直後、パワーオンリセットで再起動する場合は通常より長い 100 μs 以上のリ

5. 21-35 ページ「図 21.13 ユーザブートモードでのユーザマットへの書き込み手順」のフローについて、FPFR の判定処理を追記します。

【変更前】



【変更後】



以上